Немонотонность ползучести кристаллов LiF с разным содержанием Mg

© В.В. Шпейзман, Н.Н. Песчанская, Б.И. Смирнов

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, 194021 Санкт-Петербург, Россия

(Поступила в Редакцию 3 ноября 1997 г.)

Прецизионное измерение скорости ползучести кристаллов LiF с содержанием Mg от 0.002 до 0.03 wt% по интерферометрической записи процесса показало, что на фоне общего затухания ползучести периодически появляются немонотонности в виде чередующихся участков с относительно высокими и низкими скоростями ползучести. Накопление деформации ползучести происходит в большей степени на участках с повышенными скоростями, что обуславливает появление изломов на кривой ползучести, заметных при разрешении перемещений на уровне долей микрона. Проведено измерение высоты ступенек L по кривым "скорость-приращение деформации" при напряжениях, меньших и близких к пределу текучести. Рост напряжений приводит к падению величины L, а увеличение содержания Mg — к ее возрастанию. Предполагается, что немонотонность ползучести связана со структурной неоднородностью материала, которая определяется содержанием примесей и неоднородностью самого процесса деформирования. При малых деформациях в области площадки текучести, где деформация осуществляется в результате расширения уже существующих полос скольжения, атомы примеси усиливают неоднородность деформации (L возрастает). С ростом деформации (напряжений) L уменьшается, что сответствует сглаживанию неоднородностей. Подчеркивается, что ступенчатый характер накопления деформации является ее общей закономерностью.

Неоднородность пластической деформации, наблюдаемая в многочисленных микроскопических исследованиях, обусловлена, как известно, неоднородностью структуры материалов и неоднородностью самого процесса деформирования. Традиционные методы регистрации кривых деформации или ползучести обычно не выявляют локализованного характера образования сдвигов (кроме случаев макролокализации, например при гелиевых температурах, высоких скоростях нагружения и др.), что противоречит представлениям о развитии процесса как существенно неоднородного [1]. В последние годы стали появляться работы, в которых при использовании приборов высокого разрешения для измерения макрохарактеристик деформации была продемонстрирована ее неоднородность. В [2] были обнаружены проявления неоднородности деформации на начальных ее этапах в виде изломов на кривых нагружения (пиков скорости) для различных материалов при напряжениях, значительно меньших предела текучести. При этом скорость деформации оказалась немонотонной также на площадке текучести и вблизи нее в области пластического течения. В [3,4] показан скачкообразный характер накопления общей деформации ползучести полимеров, а в [5] проявления неоднородности деформации обнаружены при изучении релаксации напряжений в нитевидных кристаллах NaCl. Применение в [2-4] лазерного интерферометра для записи малых перемещений позволило выявить неоднородности на микронном уровне и изучить закономерности развития скачков деформации в полимерах [3,4].

В настоящей работе исследовались деформационные неоднородности при кратковременной ползучести монокристаллов LiF. Измерения проводились интерферометрической методикой, что позволяло анализировать деформации на мезоуровне, т. е. деформации, близкие по величине к локальным сдвигам, которые можно описать единичным актом перемещения мезоструктурных дефектов (полос скольжения, границ зерен или блоков, а также любых других устойчивых дислокационных скоплений). Подобные дефекты и их вклад в деформацию доступен для наблюдения в оптическом микроскопе. Исследовалось влияние величины напряжений и концентрации примеси на характеристики неоднородности деформации, для чего было изучено поведение монокристаллов LiF с различным содержанием Mg.

1. Методика эксперимента

В работе использовались три монокристалла LiF, отличающиеся концентрацией Mg (c = 0.002, 0.007 и 0.03 wt%). Монокристаллы были выращены методом Киропулоса и термообработаны путем отжига при 1020 К в течение 48 h с последующим охлаждением со скоростью 5 К/h. Из кристаллов по плоскостям спайности {100} выкалывались образцы размером 4 × 4 × 10 mm. Нагружение образцов осуществлялось одноосным сжатием вдоль направления [001], температура испытаний — комнатная.

Интерферометрический способ записи деформации во времени в виде последовательных биений [3,4], который применен в данной работе, позволяет измерять ее скорость на базе малых приращений длины образца l с погрешностью не более 5%. Одно биение на интерферограмме равно приращению деформации $\Delta l_0 = 0.3 \,\mu$ m. На рис. 1, a приведен пример кривой ползучести, ордината которой $\varepsilon = \Delta l/l$ соответствует числу колебаний на интерферограмме. Для выявления периодических изменений скорости ползучести, т. е. ступенек деформации, выбирали некоторый участок ползучести, на котором



Рис. 1. Кривая ползучести образца LiF с 0.007 wt% Mg при напряжениях $\sigma = 6$ (1), 7 (2) и 12 MPa (3) (*a*) и начальный участок ползучести в области (1) (*b*).

измеряли скорость на последовательных одинаковых приращениях деформации, Δl_0 , равных 0.15 или 0.3 μ m. Затем строили зависимость скорости от приращений деформации (кратных Δl_0). В [3,4] периоды *L* колебаний скорости как функции деформации, равные величинам (высотам) скачков деформации, определялись как произведение $L = n\Delta l_0$, где n — число измерений скорости в данном периоде. В настоящей работе за деформационную характеристику неоднородности принимали удвоенное среднее отклонение экспериментальных точек от кривой, построенной по выбранному закону ползучести методом наименьших квадратов, т.е. среднестатистическую ступеньку деформации, которая реализуется в элементарном скачке деформации на мезоуровне.

2. Результаты опытов и их обсуждение

Кривые ползучести, снятые на одном образце (LiF с 0.007% Mg) при трех различных напряжениях σ и построенные в привычном для ползучести "макромасштабе" $\varepsilon - t$, где t — время, не выявляют неоднородностей деформации (рис. 1, *a*). На рис. 1, *b* начальная часть участка *I* кривой ползучести изображена в масштабе, позволяющем разрешать микронные перемещения. Видно, что накопление деформации затухает не плавно, а идет ступенями с различной скоростью, причем на фоне общего замедления ползучести встречаются участки с возрастанием скорости. Еще более отчетливо это проявляется, если рассматривать деформационные или временные зависимости скорости деформации $\dot{\varepsilon}$.

На рис. 2 приведены примеры участков кривых ползучести при разных напряжениях для кристаллов с различным содержанием Мд в виде зависимостей "скорость деформации ($\dot{\varepsilon}$)-величина деформации (Δl)". Результаты отчетливо свидетельствуют о неравномерности деформации: ее скорость может изменяться немонотонно, зависимости величины и скорости деформации от времени не являются плавными. Заметим, что скачки скорости деформации значительно превышают погрешность измерений, так что их появление не связано с методическими причинами. По экспериментальным точкам методом наименьших квадратов была рассчитана и построена аналитическая зависимость для случая линейной связи $\ln \dot{\varepsilon}$ и ε или Δl , что эквивалентно предположению о логарифмическом законе затухания ползучести. Действительно, если, следуя многочисленным исследованиям низкотемпературной ползучести (см., например, [6]), принять логарифмический закон изменения деформации ползучести во времени

$$\varepsilon \approx \varepsilon_0 + \alpha \ln(\beta t + 1),$$
 (1)

где ε_0 , α и β — постоянные, то нетрудно получить

$$\ln \dot{\varepsilon} = A - B\varepsilon \tag{2}$$

 $(A = \ln(\alpha\beta) + \varepsilon_0/\alpha, B = 1/\alpha)$. Как показали расчеты, величина A мало изменяется при варьировании напряжений и содержания Mg, а коэффициент B закономерно растет с ростом напряжений и уменьшается с увеличением концентрации Mg (см. таблицу).

Значение коэффициента В в (2)

Содержание Mg, wt%	Напряжение, МРа			
	6	7	12	42
0.002	2300	2830	3270	
0.007	1310	1310	1590	_
0.03	—	—	—	1470

В дислокационных моделях ползучести зависимость скорости деформации от ее величины появляется, когда рассматривают энергию активации ползучести U как функцию напряжений, а последние заменяют произведением $h\varepsilon$, где h — коэффициент упрочнения. При этом оказывается B = hV/kT (V — активационный объем, k — постоянная Больцмана, T — температура). Рост величины B с увеличением напряжений можно связать с увеличением длины пробега дислокаций и, следовательно, ростом V (изменением h при малых приращениях деформаций можно пренебречь). Примесь же, вероятно,



Рис. 2. Зависимость скорости ползучести от деформации для LiF с 0.007% Mg при напряжениях 7 MPa (*a*) и LiF с 0.002% Mg при напряжениях 6 MPa (*b*). Точки — экспериментальные данные, штриховая кривая — усредненная.

этот пробег уменьшает. Не настаивая на приведенных объяснениях, заметим, что общим недостатком подобных трактовок является использование представлений о некой "средней" дислокации, свойства которой определяют макроскопическую деформацию образца. И хотя величины B, приведенные в таблице, соответствуют приемлемым значениям h и V и согласуются с приводимыми в литературе [6], анализ ползучести, оперирующий характеристиками на микроуровне, представляется в данном случае малоинформативным. В частности, в нем не находят отражения колебания скорости деформации в процессе ползучести.

Введем характеристику неоднородности деформации $L = \frac{2}{m} \sum_{l=1}^{m} \left| \Delta l_{exp} - \Delta l_{cal} \right|_{i}$, где суммирование ведется по всем *m* точкам кривой $\dot{\varepsilon}(\Delta l)$, а Δl_{exp} и Δl_{cal} — экспериментальное и рассчитанное по плавной кривой значения деформации соответственно. На рис. 3 приведены зависимости L от напряжений σ для LiF с 0.002 и 0.007% Mg. Поскольку были выбраны участки кривых ползучести с примерно равными скоростями, то увеличению напряжений на рис. 3 соответствует и увеличение деформации (от 1.5% при 6 MPa до 7.1% при 15 MPa). Уменьшение L с ростом напряжений (или деформации) свидетельствует о выравнивании скорости ползучести, что связано, повидимому, с большей однородностью деформированной структуры и уменьшением степени локализации деформации, т.е. вовлечением в деформацию все большего числа мест. Таким образом, деформационное упрочнение

приводит, как видно из рис. 3, к уменьшению величины L. Обратный результат получен нами при анализе влияния на параметр неоднородности деформации L в случае упрочнения, вызванного легированием (рис. 4). Изменение L от содержания Mg построено для однотипных условий эксперимента: одинаковой деформации (около 4%) и напряжений, близких к пределу текучести (7, 12 и 42 MPa для кристаллов LiF с 0.0024, 0.007 и 0.03% Mg,



Рис. 3. Зависимость среднестатистической характеристики неоднородности деформации L(1,2) и отношения максимальной и минимальной скоростей деформации в ступеньке (3) от напряжения для LiF с 0.007% Mg (1, 3) и 0.002% Mg (2).



Рис. 4. Влияние содержания Mg на неоднородность деформации при напряжениях, близких к пределу текучести (7, 12 и 42 MPa для LiF с 0.002, 0.007 и 0.03% Mg соответственно).

соответственно). Увеличение L с ростом концентрации Mg связано, вероятно, с тем, что распределение Mg в кристалле создает дополнительную неоднородность деформации и усиливает ее локализацию. Представляется, что в зависимости от вида примеси, способа ее введения, термообработки величина L будет изменяться и, следовательно, по ней можно судить о неоднородности распределения примеси и ее влиянии на деформацию.

Значения L, полученные в настоящей работе, лежат в интервале 0.4–1.2 µm. Для монокристаллов LiF — это размер, близкий по величине к ширине границы полосы скольжения [1]. Можно полагать, что именно процессы в этих приграничных зонах (например, расширение полос скольжения) определяют деформацию. В [1] было показано, что деформация в рассматриваемом диапазоне изменений условий опыта осуществляется движением края полосы скольжения (расширением полосы) при сохранении постоянной величины сдвига в полосе. Размер граничной зоны по данным измерений в интерференционном микроскопе не превышал $2 \,\mu m$, что не противоречит приведенной трактовке результатов. Новая характеристика деформации, описывающая ее неоднородность, позволяет при построении модели деформации выделить саму границу или некоторую ее часть как самостоятельный элемент структуры и рассматривать ее перемещение как целого.

Поскольку сдвиг γ в полосе скольжения на начальных стадиях деформации постоянен [1], величину осевого перемещения Δl в результате движения границы полосы можно определить как $\gamma s/\sqrt{2}$, где s — среднее смещение границы в направлении, перпендикулярном ее плоскости. С помощью этого выражения можно попытаться объяснить рост L при легировании. Действительно, γ растет линейно с увеличением предела текучести, вызванного добавкой Mg, с коэффициентом пропорциональности $1 \cdot 10^{-3}$ MPa⁻¹ [1]. Учитывая, что для использованных в настоящей работе кристаллов пределы текучести (осевые напряжения) составляли 7, 12 и 42 MPa, получим, что L увеличивается с ростом предела текучести с коэффициентом 2 $\cdot 10^{-2}$ MPa⁻¹ (рис. 4). Следовательно,

одним только увеличением величины сдвига в полосе скольжения нельзя объяснить рост L при легировании. Таким образом, и уменьшение L с ростом напряжений (деформаций), и увеличение L при добавлении Mg (если сравнение проводить на уровне предела текучести при близких значениях деформации) следует связывать с изменением величины элементарного смещения границы полосы сдвига. Влияние степени деформации можно объяснить сближением соседних полос и выравниванием локальных сдвигов по длине образца, примесь же, очевидно, усиливает неоднородность деформации за счет создания дополнительных препятствий для зарождения и развития полос скольжения.

Заметим, что изменение скорости деформации в пределах одного скачка деформации было невелико, изменение отношения $\dot{\varepsilon}_{max}/\dot{\varepsilon}_{min}$ не превышало 1.65, а его зависимость от напряжений и степени легирования повторяло аналогичные зависимости для *L* (см. кривую *3* на рис. 3). Подобный результат обусловлен хорошей аппроксимацией в нашем случае данных по логарифмическому закону. В других случаях, например, для стационарной ползучести, где предложенный способ оценки *L* неприменим, для анализа неравномерности скорости можно воспользоваться приемами, изложенными в [3,4], которые дают независимые величины отношения скоростей и деформационную характеристику неоднородности деформации.

Таким образом, в настоящей работе предлагается новый способ анализа деформации на мезоскопическом уровне и предложена ее новая характеристика — временная неоднородность деформации *L*. Последняя вводится как средний размах колебаний деформации в ее отклонениях от предполагаемой линейной зависимости $\ln \dot{\varepsilon} - \varepsilon$. В результате показано, что в кристаллах LiF с примесью Mg величина *L* падает с ростом деформации (напряжений) и растет при увеличении содержания Mg. Предполагается, что *L*, величина которой изменялась в наших опытах от 0.4 до 1.2 μ m, определяется смещением границы полосы скольжения при ее расширении. Этот процесс, как известно по данным структурных исследований, вносит основной вклад в деформацию на начальной ее стадии.

Список литературы

- [1] Б.И. Смирнов. Дислокационная структура и упрочнение кристаллов. Наука, Л. (1981). 235 с.
- [2] В.В. Шпейзман, Н.Н. Песчанская, В.А. Степанов. ФТТ 26, 8, 2387 (1984).
- [3] Н.Н. Песчанская, П.Н. Якушев. ФТТ 30, 7, 2196 (1988).
- [4] Н.Н. Песчанская. Высокомолекуляр. соединения A 31, 6, 1181 (1989).
- [5] С.У. Гольденберг, О.Д. Хлебников. ФТТ 32, 4, 1226 (1990).
- [6] J. Weertman, J.R. Weertman. In: Physical Metallurgy / Ed. R.W. Cahn. North-Holland Publ. Comp., Amsterdam (1965).
 V. 3. (Физическое металловедение. Мир, М. (1968) Т. 3).